

MAST5-5A 型 IGBT 驱动板

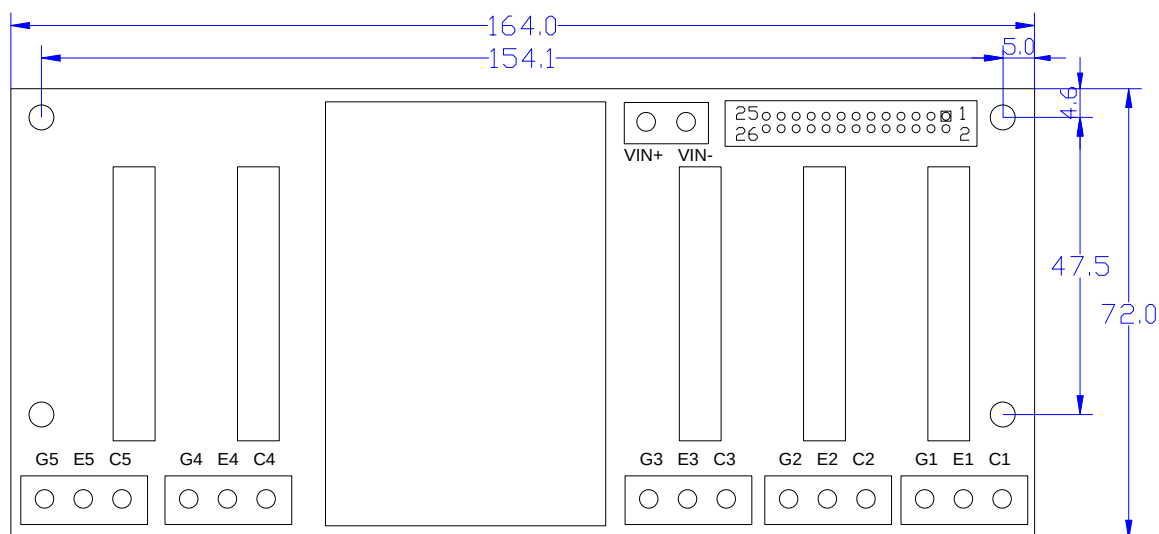


使用 说 明

一：功能描述

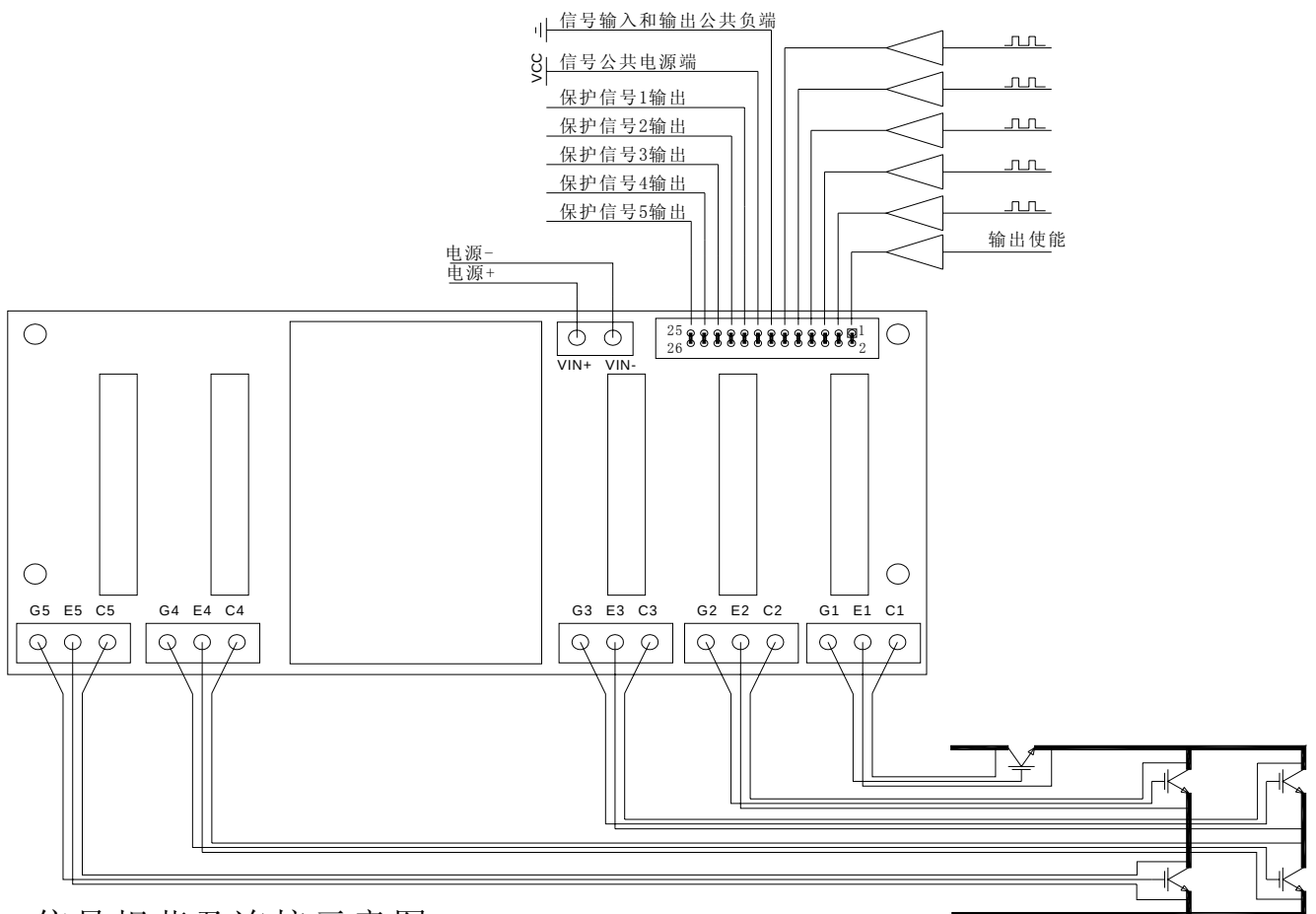
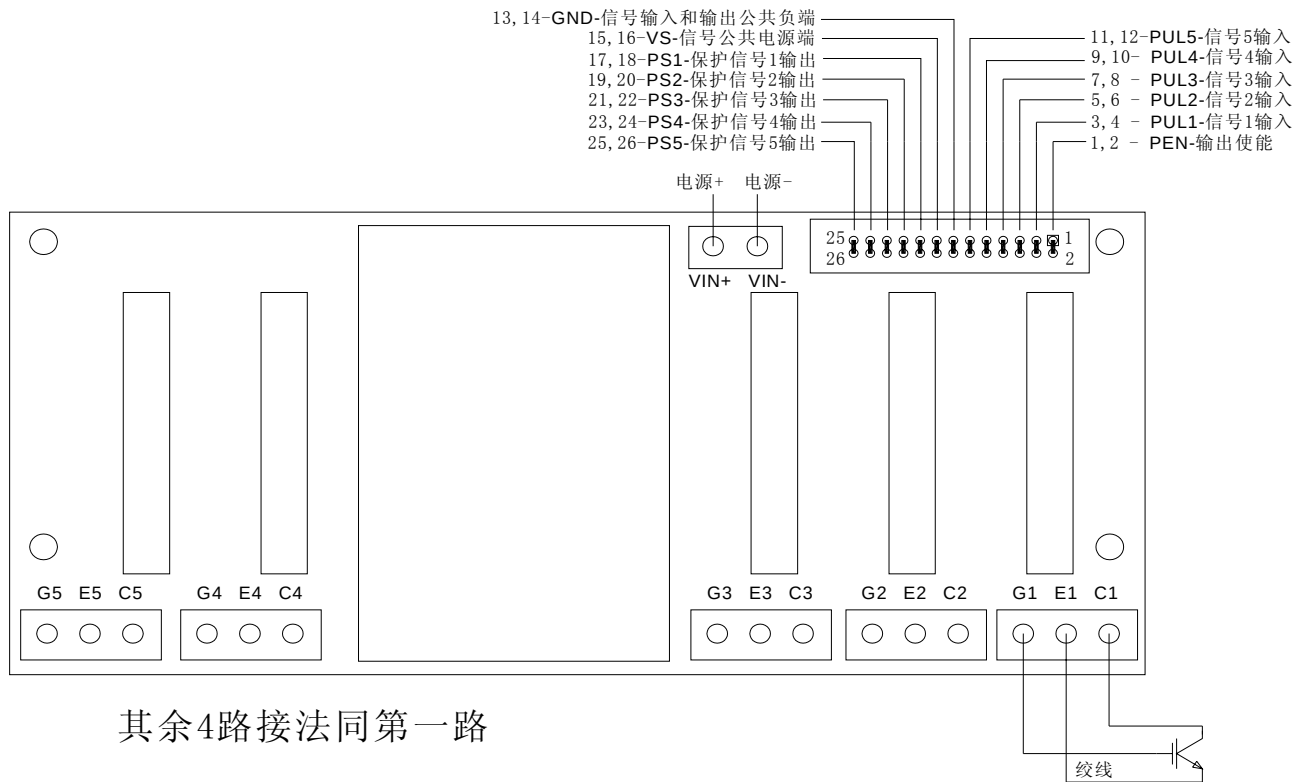
- 内置 5 路 IGBT 驱动，采用 AST965，每路驱动电流均为 5A。
- 内置 5 路相互隔离 DC-DC，隔离电压 3000VAC。
- **电流源驱动方式**，在同等 EMI 情况下，减小密勒效应时间，降低开关损耗。
- 每路均具有 V_{CE} 检测方式的短路保护。
- 每路均具有欠压保护。
- 每路均具有 IGBT 栅极 TVS 保护元件。
- 每路均具有电源指示、脉冲指示。
- 集中的扁平线信号接口，支持多种输入电平。
- 外部只需输入 1 路电源 12VDC (9-18V)，或 24VDC (18-32V)

二：结构和尺寸



板总高度：38mm。

三：连接及说明



信号规范及连接示意图

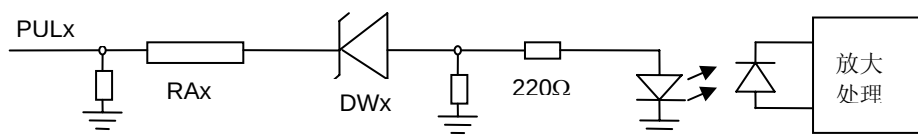
1、扁平线引脚定义描述表

序号	功能号	描 述
1	PEN	驱动输出使能，如 PEN 为低电平，则无论输入信号如何变化，所有驱动输出保持为负电位；PEN 为高电平时，允许驱动输出为高（根据输入信号变化）；PEN 信号须有 1mA 以上的高电平驱动能力
2		
3	PUL1	第一路信号输入（信号 1 输入），当 PEN 为高时，信号输入为高时，驱动输出正电位，信号输入为低时，驱动输出负电位。信号输入须具有 8mA 以上的高电平驱动能力
4		
5	PUL2	第二路信号输入（信号 2 输入），当 PEN 为高时，信号输入为高时，驱动输出正电位，信号输入为低时，驱动输出负电位。信号输入须具有 8mA 以上的高电平驱动能力
6		
7	PUL3	第三路信号输入（信号 3 输入），当 PEN 为高时，信号输入为高时，驱动输出正电位，信号输入为低时，驱动输出负电位。信号输入须具有 8mA 以上的高电平驱动能力
8		
9	PUL4	第四路信号输入（信号 4 输入），当 PEN 为高时，信号输入为高时，驱动输出正电位，信号输入为低时，驱动输出负电位。信号输入须具有 8mA 以上的高电平驱动能力
10		
11	PUL5	第五路信号输入（信号 5 输入），当 PEN 为高时，信号输入为高时，驱动输出正电位，信号输入为低时，驱动输出负电位。信号输入须具有 8mA 以上的高电平驱动能力
12		
13	GND	信号输入和保护信号输出的公共负端，一般接 GND
14		
15	VS	保护信号输出的公共正端，一般接 VCC（3.3V、5V、12V 或 15V）
16		
17	PS1	第一路保护信号输出，当检测到短路保护或欠压保护时，该引脚输出高电位。
18		
19	PS2	第二路保护信号输出，当检测到短路保护或欠压保护时，该引脚输出高电位。
20		
21	PS3	第三路保护信号输出，当检测到短路保护或欠压保护时，该引脚输出高电位。
22		
23	PS4	第四路保护信号输出，当检测到短路保护或欠压保护时，该引脚输出高电位。
24		
25	PS5	第五路保护信号输出，当检测到短路保护或欠压保护时，该引脚输出高电位。
26		

注：扁平线插座均为双线并连在一起，即：1,2 脚连接在一起，3,4 脚连接在一起，.....25,26 脚连接在一起。

2、信号输入说明

板内信号每路的输入电路如图所示：



其中：x=1,2,3,4,5。

信号输入为共负端输入，要求每路具有高电平 8mA 以上驱动能力，对于 5V 信号接口，推荐信号使用 74F125、74HC245 等驱动后再送至驱动板；对于 12V 或 15V 信号接口，推荐信号使用 CD4050 等驱动后再送至驱动板。如信号输入没有足够的驱动能力，IGBT 驱动输出可能不稳定。

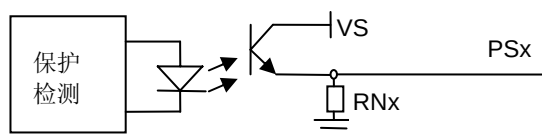
缺省的元件值为 5V 或 3.3V 输入信号电平，如输入信号电平是 12V、15V 或 24V，可以改变 RA1-RA5 以及 DW1-DW5 值进行匹配。

	3.3V	5V	12-15V	24V
RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	0Ω电阻	0Ω电阻	680Ω电阻	2KΩ电阻
DW1,DW2,DW3,DW4,DW5	0Ω电阻	0Ω电阻	0Ω电阻	5.1V 稳压管

注：信号电平为 24V 时，DW1-DW5 安装 5.1V 稳压管，可以提高信号传输抗干扰能力，可用于较远距离传输信号，例如 2m 以上。

3、保护信号输出说明

板内每路保护信号输出电路如图所示：



其中：x=1,2,3,4,5。

板上 5 路 IGBT 驱动的保护信号均单独输出，输出的信号类似于光电耦合器，其 C 极接信号电源端，其 E 极引出保护信号，并通过 RN1-RN5 接地。当保护发生时，C 极和 E 极导通，PS1—PS5 输出高电平；保护解除时，C 极和 E 极截止，PS1—PS5 输出低电平。

C 极和 E 极截止耐压为 30V，因此，可根据需要配置成 5V（3.3V）、12V、15V

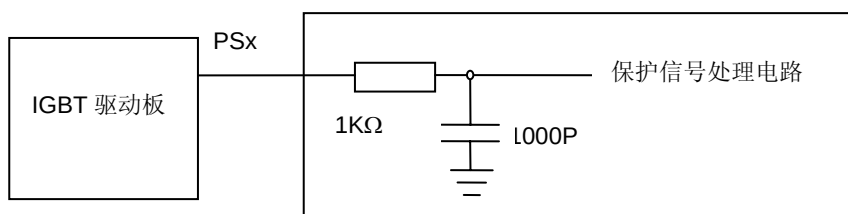
或 24V 系统。

不同 VS 情况下所使用的 RNx 电阻值如下表：

	3.3V	5V	12-15V	24V
RN1,RN2,RN3,RN4,RN5	680Ω电阻	680Ω电阻	2KΩ电阻	5.1KΩ电阻

注：VS 在板内仅连接保护信号输出电路，其它电路未使用 VS。

如图所示，该输出信号是电阻下拉输出信号，请实际使用时注意信号的驱动能力，应选择输入电流较小的输入电路。同时，为了增强抗干扰能力，请使用一个阻容输入电路：



4、电源输入

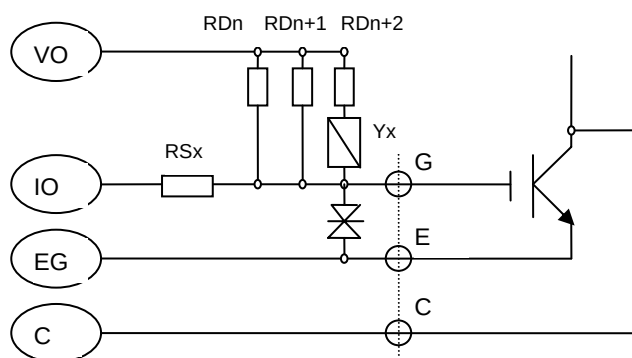
在 VIN+和 VIN-分别输入电源的正极和负极，电压可以有 12V 和 24V 两种。

连接电源时请注意电源输入的极性和电压值。

电源电路、信号输入和保护信号输出电路、驱动输出电路三者是相互隔离的。

5、驱动输出电路

5.1、驱动输出电路如图所示：



其中：n=1,4,7,10,13；x=1,2,3,4,5。

RSx 为“电流源驱动启动的 0 欧电阻”，如 RSx 安装一个 0 欧电阻，则为电流源驱动方式；如 RSx 空，则为电压源—电阻驱动方式。RDn、RDn+1、RDn+2 分

别为驱动电流控制电阻，驱动电流大小见下文，其中 RD_{n+2} 受 Y_x 的影响， Y_x 为 IGBT 开通/关断采用不同驱动电流的控制元件，如在 Y_x 位置安装一个二极管（应选择肖特基二极管），通过安装二极管的方向，可以达到慢速开通/快速关断，或快速开通/慢速关断的目的（图示中，二极管 A 极在下，K 极在上时是慢速开通/快速关断）。

5.2、与驱动方式和驱动电流大小相关的元件：

路数	驱动电流控制电阻	电流源驱动启动的 0 欧电阻	IGBT 开通/关断采用不同驱动电流控制
第一路	RD1、RD2、RD3	RS1	Y1
第二路	RD4、RD5、RD6	RS2	Y2
第三路	RD7、RD8、RD9	RS3	Y3
第四路	RD10、RD11、RD12	RS4	Y4
第五路	RD13、RD14、RD15	RS5	Y5

5.3、驱动电流的计算

计算方法与 AST965 模块相同，以第一路为例：采用电流源驱动时（RS1 安装 0 欧电阻），且如果 RD3 和 Y1 均为空，则 RD1、RD2 在板上是并联的，第一路的驱动电流即为：

$$I = 0.4 + \frac{2}{RD1 // RD2} \quad (A) \quad \text{其中 } RD1 // RD2 \text{ 为两个电阻并联值。}$$

驱动板出厂时驱动电流缺省值为 2.2A，两个电阻均为 2.2Ω。

每一路均可以单独使用不同的驱动方式和驱动电流值。

5.4、几种应用的元器件选取举例

序	驱动方式	驱动电流 开通/关断	RDn	RDn+1	RDn+2	RSx	Yx
1	电流源	1.2A/1.2A	5.1Ω	5.1Ω	空	0Ω	空
2		2.2A/2.2A	2.2Ω	2.2Ω	空	0Ω	空
3		3.1A/3.1A	1.5Ω	1.5Ω	空	0Ω	空
4		4A / 4A	1.5Ω	1.5Ω	2.2Ω	0Ω	0Ω电阻
5		5A / 5A	1.0Ω	1.0Ω	3.3Ω	0Ω	0Ω电阻
6		2.2A/4.2A	2.2Ω	2.2Ω	1.0Ω	0Ω	S24 二极管
7		3.2A/1.2A	5.1Ω	5.1Ω	1.0Ω	0Ω	S24 二极管
8		1A/1A	47Ω	47Ω	空	空	空
9		2A/2A	22Ω	22Ω	空	空	空

10	电压源— 电阻	3A/3A	22Ω	22Ω	22Ω	空	0Ω电阻
11		4A/4A	15Ω	15Ω	15Ω	空	0Ω电阻
12		5A/5A	12Ω	12Ω	12Ω	空	0Ω电阻
13		2A/4A	22Ω	22Ω	10Ω	空	S24 二极管
14		3A/1A	47Ω	47Ω	10Ω	空	S24 二极管

注：二极管 S24 的安装方向参见 5.1 图示和说明。

5.5、电流源驱动与电压源—电阻驱动的对比如表：(仅供参考)

电流源驱动 驱动电流	2.0μC 栅极电荷时 栅极脉冲上升时间	电压源-电阻驱动 驱动电阻/峰值电流	2.0uC 栅极电荷时 栅极脉冲上升时间
1A	约 2.0μS	15Ω / 1.6A	约 3.1μS
2A	约 1.0μS	10Ω / 2.4A	约 2.1μS
3A	约 0.67μS	7.5Ω / 3.2A	约 1.56μS
4A	约 0.5μS	5Ω / 4.8A	约 1.0μS
5A	约 0.4μS	3.3Ω / 7.3A	约 0.69μS
电流源驱动 驱动电流	3.0μC 栅极电荷时 栅极脉冲上升时间	电压源-电阻驱动 驱动电阻/峰值电流	3uC 栅极电荷时栅 极脉冲上升时间
2A	约 1.5μS	10Ω / 2.4A	约 3.1μS
3A	约 1.0μS	7.5Ω / 3.2A	约 2.34μS
4A	约 0.75μS	5Ω / 4.8A	约 1.56μS
5A	约 0.6μS	3.3Ω / 7.3A	约 1.03μS
6A	约 0.5μS	2.0Ω / 12A	约 0.63μS
电流源驱动 驱动电流	4μC 栅极电荷时栅 极脉冲上升时间	电压源-电阻驱动 驱动电阻/峰值电流	4uC 栅极电荷时栅 极脉冲上升时间
2A	约 2.0μS	10Ω / 2.4A	约 4.16μS
3A	约 1.33μS	7.5Ω / 3.2A	约 3.1μS
4A	约 1.0μS	5Ω / 4.8A	约 2.1μS
5A	约 0.8μS	3.3Ω / 7.3A	约 1.4μS
6A	约 0.67μS	2.0Ω / 12A	约 0.83μS

注：IGBT 栅极电荷主要由输入栅极电容电荷和密勒效应电荷组成，不同工艺、不同制造商的 IGBT 栅极电荷各有不同，一般 IGBT 容量越大，栅极电荷也越大，具体

数值请参见 IGBT 数据手册。

6、短路保护动作时间调整

如果所驱动的 IGBT 模块工作电流大、导通压降较高且开关速度较低，短路保护动作过快时可能产生误动作，在排除欠压保护的可能性后，可适当调节短路保护的動作时间，方法是在 Cx (x=1,2,3,4,5) 上安装一个频率特性较好的电容，以使短路保护动作时间延长，每 1000PF 的电容器大约产生 1uS 的延时。需要注意的是：如延时时间过长，在短路时可能不能有效的保护 IGBT，或者缩短其寿命；一般情况下不需要调整短路保护动作时间。

四：电气规范

极限参数：

项目	代号	条件	值	单位
电源电压	VDD	VDD-VSS (24V)	36	V
		VDD-VSS (12V)	20	V
输入电压	V _I		-7~7	V
运行频率	F _{OP}		0—100K	Hz
耐电压	V _{RMS}	50Hz 正弦有效值	3000V	V
最大功率消耗	P _D		20	W
运行环境温度	T _{OP}		-25—70	°C
储藏温度	T _{STG}		-25—100	°C

电气参数：(T=25°C)

项目	代号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	VDD	VDD-VSS (24V)	18	24	32	V
		VDD-VSS (12V)	9	12	18	V
电源电流 (20KHz, 负载电容 0.1uF)	IDD	VDD-VSS (24V)		0.52	1.0	A
		VDD-VSS (12V)		1.10	2.0	A
输入电压	V _{IN}		4	5	6	V
“H”输入电流	I _{IH}	V _{IN} =5V		14		mA
“H”输出电压	V _{OH}	驱动 IGBT, VDD=20—30V	14	15		V
“L”输出电压	V _{OL}	驱动 IGBT, VDD=30V		-13		V

		驱动 IGBT,VDD=24V		-8		V
		驱动 IGBT,VDD=20V		-4		V
上升时间	T_R	空载		0.1		μS
上升时间	T_R	负载	取决于负载电容量			
下降时间	T_F	空载		0.1		μS
下降时间	T_F	负载	取决于负载电容量			
上升延时时间	T_{PDH}	空载		0.5		μS
上升延时时间	T_{PDH}	负载	取决于负载电容量			
下降延时时间	T_{PDL}	负载	取决于负载电容量			
共模电压	CMRR		15	30		KV/ μS
短路保护时间	T_{SCP}	从短路发生到栅极电压下降到 6V 以下		6	9	μS
欠压保护动作	V_{LVP}			18		V
保护信号光耦负载电流	I_{FO}			5		mA
保护信号光耦耐压	V_{FOMAX}			30		V
保护复位时间	T_{RST}			80		mS
检测二极管耐压	V_{DIODE}		1800	2000		V
检测二极管恢复	T_{rr}	$I_F=0.5A$	50	75		nS

推荐使用条件:

项目	代号	条件	值	单位
电源电压	VDD	VDD-VSS (24V)	24 ± 4	V
		VDD-VSS (12V)	12 ± 2	
输入电压	V_I		5	V
最大脉冲输出电流	I_{OP}	F=40KHz	$\pm 0.4 - \pm 2.5$	A
		F=20KHz	$\pm 0.4 - \pm 5.0$	A
运行环境温度	T_{OP}		≤ 60	$^{\circ}C$
驱动 IGBT 类型	环境温度 40 $^{\circ}C$, F=20KHz, 200A/1700V, 200A/1200V, 400A/600V 环境温度 60 $^{\circ}C$, F=20KHz, 100A/1700V, 100A/1200V, 200A/600V 环境温度 40 $^{\circ}C$, F=8KHz, 400A/1700V, 400A/1200V, 600A/600V 环境温度 60 $^{\circ}C$, F=8KHz, 200A/1700V, 200A/1200V, 400A/600V			

五：其它注意事项

- 1、IGBT 开关时的 dv/dt 和 di/dt 很高，在主板连接到驱动板的扁平线上套一个扁磁环，可降低对电子线路的电磁干扰。在每路 IGBT 的三根驱动连接线上也各套一个圆柱磁环，也可降低电磁干扰。还可以在输入电源线上也套一个圆柱磁环。
- 2、设计 IGBT 驱动板位置时，应尽量靠近 IGBT，使驱动板至 IGBT 的连接线路尽量短，这样驱动波形更佳，电路工作更可靠，但还要考虑靠近 IGBT 是否导致驱动板环境温度过高，如果驱动板环境温度过高，驱动板应该要降额使用。
- 3、注意输入电源需要有一定的功率裕量，否则在带负载情况下，驱动板上的开关电源可能不能正常启动。例如以 20KHz 的频率驱动 4 路 300A 的 IGBT，正常工作时，输入 24V 或 12V 电源的总功率可能只有 12W 左右，但为保证带负载正常启动，输入电源需要提供 24W 左右的瞬时启动功率，启动持续时间在 1S 以内。所以，一般应按照最大电源电流值选取供电电源。